## Оптический журнал

Обмен опытом

УДК 535.232.65

# Методика измерения мощности излучения исследуемого материала и модели абсолютно черного тела для определения нормальной излучательной способности материала

© 2020 г. В. Я. Менделеев, канд. техн. наук; В. В. Качалов, канд. техн. наук

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, Москва E-mail: v\_mendeleyev@list.ru

Поступила в редакцию 11.10.2019

DOI:10.17586/1023-5086-2020-87-01-77-80

При измерениях нормальной излучательной способности материалов предполагают, что плотность потока излучения на поверхности исследуемого материала и модели абсолютно черного тела распределена равномерно. Однако из-за конструктивных особенностей нагревателей исследуемого материала и модели абсолютно черного тела это предположение не всегда выполняется. В настоящей статье предложена методика измерения мощности излучения поверхностей исследуемого материала и модели абсолютно черного тела, имеющих равномерную плотность потока излучения в центральной области поверхностей. Возможность измерения мощности излучения поверхности с равномерной плотностью потока излучения подтверждена экспериментально на образце оксида алюминия при температуре 1195 К.

**Ключевые слова:** излучательная способность, плотность потока излучения, мощность излучения, площадь излучающей поверхности.

**Коды OCIS:** 120.5630, 120.4640

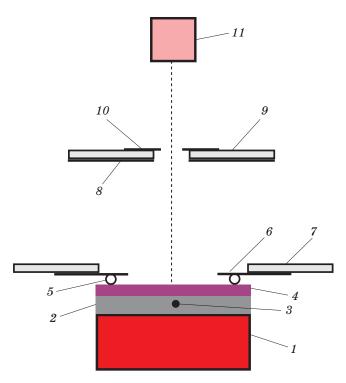
Важной характеристикой материалов, участвующих в теплообмене излучением, является нормальная излучательная способность («нормальная» — в направлении, перпендикулярном излучающей поверхности) [1]. Эта характеристика определяется как отношение нормальной мощности теплового излучения (далее «мощность излучения») исследуемого материала к мощности излучения модели абсолютно черного тела (АЧТ), измеренных одним и тем же измерителем мощности при одинаковых температурах и размерах излучающих поверхностей. При этом полагается [2-7], что нормальные плотности потоков излучения (далее «плотность потока») исследуемого материала и модели АЧТ распределены равномерно по площади излучающей поверхности. Однако из-за конструктивных особенностей нагревателей исследуемого материала и модели АЧТ [8, 9] плотность потоков указанных излучающих поверхностей может быть распределена неравномерно. Эти неравномерности могут приводить к дополнительной погрешности определения нормальной излучательной способности исследуемого материала. Возможным путем решения этой проблемы является измерение мощности излучения в центральной области поверхности, где исследуемый материал и модель АЧТ имеют равномерное распределение плотностей потоков теплового излучения, описываемое линейной зависимостью мощности излучения от площади излучающей поверхности [10].

В настоящем исследовании полагается, что плотности потоков излучения распределены равномерно в центральной области поверхностей и неравномерно за пределами центральной области.

Возможность измерения мощности излучения поверхности с равномерным распределением потока теплового излучения в центральной области поверхности исследовалась экспериментально на образце оксида алюминия при температуре 1195 К. Это исследование показало возможность измерения мощности излучения поверхности с равномерным распределением потока излучения по линейной зависимости мощности излучения от площади излучающей поверхности. На основании результатов этого исследования предложена методика измерения мощности излучения поверхности исследуемого материала и модели АЧТ.

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Структурная схема экспериментальной установки для измерения мощности излучения образца из оксида алюминия представлена на рис. 1. В состав нагревателя установки входит нагревательный элемент, выполненный из проволоки Pt/Rh30, который установлен в обечайку из высокотемпературной керамики OXIDAL—1750 ( $Al_2O_3 - 99,5\%$  и  $SiO_2 - 0,3\%$ ). Размер нагревательного элемента составляет  $30\times30$  мм. На нагреватель установлена подложка из двух никелевых пластин, между которыми вставлен королек хромель-алюмелевой термопары. На никелевую подложку помещается исследуемый образец квадратной формы со стороной 30 мм и толщиной 3 мм из оксида алюминия

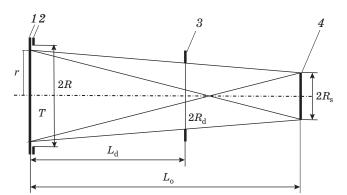


**Рис. 1.** Структурная схема экспериментальной установки для измерения мощности излучения. 1 — нагреватель, 2 — никелевая подложка, 3 — электроды хромель-алюмелевой термопары, 4 — исследуемый образец, 5 — соломка из оксида алюминия, 6 — экран, 7 — стальной фланец  $\mathbb{N}$  1 с водяным охлаждением, 8 — медная пластина с поглощающим покрытием, 9 — стальной фланец  $\mathbb{N}$  2, 10 — диафрагма, 11 — приемник теплового излучения.

 $({\rm Al_2O_3} - 99,8\%$  и MgO - 0,2%). Размер излучающей поверхности образца ограничивается медным экраном со световым диаметром 30 мм. Экран размещен на стальном водоохлаждаемом фланце (№ 1). Между экраном и излучающей поверхностью исследуемого образца помещены соломки из оксида алюминия диаметром 1 мм. На расстоянии 115 мм от поверхности образца на стальном фланце (№ 2) с поглощающим покрытием установлена медная диафрагма. Чувствительная площадка приемника теплового излучения находится на расстоянии 320 мм от поверхности исследуемого образца. Приемник S302C теплового излучения с чувствительной площадкой диаметром 12 мм имеет спектральный интервал измерений 0,19-25 мкм и диапазон измерения мощности от  $10^2$  до  $2 \times 10^6$  мкВт.

На оптической схеме экспериментальной установки, приведенной на рис. 2, поверхность образца материала при температуре T ограничивается экраном радиусом R, кроме этого, она включает диафрагму с радиусом световой апертуры  $R_{\rm d}$  и чувствительную площадку приемника теплового излучения радиусом  $R_{\rm s}$ . В рассматриваемой схеме радиус  $R_{\rm s}$ , расстояние  $L_{\rm d}$  от поверхности образца до диафрагмы и расстояние  $L_0$  от поверхности образца до чувствительной площадки приемника являются фиксированными. При этом размер чувствительной площадки приемника существенно меньше расстояния до излучающей поверхности и виньетированием излучения можно пренебречь. Радиус световой апертуры диафрагмы может изменяться, при этом меняется и площадь поверхности, излучающей на чувствительную площадку приемника.

Из оптической схемы (рис. 2) следует, что радиус *r* поверхности, излучающей на чувствитель-



**Рис. 2.** Оптическая схема экспериментальной установки. 1 — образец материала при температуре T, 2 — экран, 3 — диафрагма, 4 — чувствительная площадка приемника теплового излучения, R — радиус световой апертуры экрана, r — радиус поверхности, излучающей на чувствительную площадку приемника 4,  $R_{\rm d}$  — радиус световой апертуры диафрагмы 3,  $R_{\rm s}$  — радиус чувствительной площадки 4,  $L_{\rm d}$  и  $L_{\rm o}$  — расстояния от поверхности образца до диафрагмы 3 и до чувствительной площадки 4 соответственно.

ную площадку приемника, описывается выражением

$$r = (R_{\rm d}L_{\rm o} - R_{\rm s}L_{\rm d})/(L_{\rm o} - L_{\rm d}).$$
 (1)

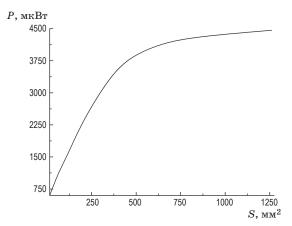
## РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В экспериментах применялись сменные диафрагмы с диаметрами светового отверстия 7, 10, 12, 14,5, 17,5, 19,5, 22, 24,5 и 30 мм.

При исследовании образца оксида алюминия мощность излучения, падающего на чувствительную площадку приемника, измерялась с каждой сменной диафрагмой при температуре нагревателя 1195 К. При этом радиус излучающей поверхности рассчитывался по соотношению (1). На рис. 3 приведен график зависимости измеренной мощности P излучения от площади S излучающей поверхности  $S=\pi r^2$ .

В центральной области поверхности вплоть до значений, близких к  $S \approx 170~\mathrm{mm}^2$ , график, приведенный на рис. 3, хорошо аппроксимируется линейной зависимостью  $P = P_\mathrm{O} + aS$ , где  $P_\mathrm{O} = 492,31~\mathrm{mkBr}$  и  $a = 9,296~\mathrm{mkBr/mm}^2$ . При дальнейшем увеличении площади излучающей поверхности вплоть до 707 мм² ( $2R \approx 30~\mathrm{mm}$ ) зависимость мощности излучения от площади излучающей поверхности становится существенно нелинейной, что связано с уменьшением температуры поверхности на периферии нагревателя. Некоторое увеличение мощности излучения при площади излучающей поверхности более 707 мм² ( $2R > 30~\mathrm{mm}$ ) можно объяснить вкладом теплового излучения экрана в регистрируемую мощность излучения.

Таким образом, из графика, приведенного на рис. 3, следует, что экспериментальная зависимость мощности излучения оксида алюминия от площади излучающей поверхности хорошо аппроксимируется линейной зависимостью в цен-



**Рис. 3.** Экспериментальная зависимость мощности P излучения от площади S поверхности, излучающей на чувствительную площадку приемника излучения.

тральной области поверхности вплоть до площади излучающей поверхности  $170 \text{ мм}^2 (2r \approx 14.8 \text{ мм}).$ 

Этот результат позволяет полагать, что аналогичным образом может быть получена линейная зависимость мощности излучения модели АЧТ от площади излучающей поверхности при такой же температуре 1195 К. В этом случае мощности излучения, полученные при одинаковых площадях поверхностей исследуемого материала и модели АЧТ, можно использовать для определения излучательной способности исследуемого материала.

## МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ

На основании описанных выше результатов методику измерения мощности излучения поверхностей исследуемого материала и модели АЧТ для определения излучательной способности исследуемого материала при заданной температуре можно представить следующей последовательностью процедур:

- 1) экспериментальное определение зависимостей мощности излучения исследуемого материала и модели АЧТ от площади излучающих поверхностей,
- 2) выделение на экспериментальных зависимостях исследуемого материала и модели АЧТ участков линейной зависимости мощности излучения от площади излучающей поверхности,
- 3) определение значений мощности излучения, соответствующих одинаковым площадям поверхности исследуемого материала и модели АЧТ на выделенных линейных участках зависимостей мощности излучения от площади поверхности,
- 4) применение полученных значений для определения излучательной способности исследуемого материала при заданной температуре.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспериментально исследована зависимость мощности излучения оксида алюминия от площади излучающей поверхности при температуре 1195 К. В центральной области поверхности площадью вплоть до 170 мм² обнаружена линейная зависимость мощности излучения от площади излучающей поверхности, свидетельствующая о равномерной плотности потока излучения. Для определения излучательной способности исследуемого материала предложена методика измерения мощности излучения материала и модели абсолютно черного тела в области линейной зависимости мощности излучения от площади излучающих поверхностей.

Авторы благодарны В.В. Пилипенко и В.А. Моздыкову за помощь в подготовке экспериментальной установки.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. Л.: Энергия, 1971. 294 с.
- 2. Hanssen L., Wilthan B., Monte C., et al. Report on the CCT supplementary comparison S1 of infrared spectral normal emittance/emissivity // Metrologia. 2016. V. 53 (Technical Suppl): 03001.
- 3. Campo L., Pérez-Sáez R.B., Esquisabel X., et al. New experimental device for infrared spectral directional emissivity measurements in a controlled environment // Rev. Sci. Instrum. 2006. V. 77. P. 113111.
- 4. Varaksin A.Yu., Romash M.E., Kopeitsev V.N. The possibility of generation of concentrated fire vortices without forced swirling // Doklady Physics. 2014. V. 59. № 5. P. 203–205.
- 5. Li L., Yu K., Zhang K., et al. Study of Ti-6Al-4V alloy spectral emissivity characteristics during thermal oxidation process // Int. J. Heat Mass Tran. 2016. V. 101. P. 699-706.
- 6. Liang H., Yang F., Wang G., et al. Study of the optical and absorption properties of micro-nanostructure on metal surfaces // Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 2. С. 28–33.
- 7. *Перцович Б.В., Живоносновская А.С., Скворцов Д.М.* Имитационное моделирование сигнатуры теплового объекта // Оптический журнал. 2018. Т. 85. № 4. С. 28–35.
- 8. Hanssen L., Mekhontsev S., Khromchenko V. Infrared spectral emissivity characterization facility at NIST // Proc. SPIE. 2004. V. 5405. P. 1-12.
- 9. Monte C., Hollandt J. The measurement of directional spectral emissivity in the temperature range from 80 °C to 500 °C at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt // High Temperatures-High Pressures. 2010. V. 39. P. 151–164.
- 10. Излучательные свойства твердых материалов / Под ред. Шейндлина А.Е. М.: Энергия, 1974. 473 с.